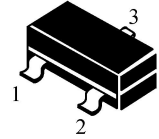




GMD780

SOT-23

- 1. BASE
- 2. EMITTER
- 3. COLLECTOR



■FEATURES 特點

NPN Low Frequency Amplifier Transistor

■MAXIMUM RATINGS (T_a=25°C) 最大額定值

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Rating 額定值	Unit 單位
Collector-Base Voltage 集電極-基極電壓	V _{CB0}	60	V
Collector-Emitter Voltage 集電極-發射極電壓	V _{CEO}	60	V
Emitter-Base Voltage 發射極-基極電壓	V _{EBO}	5	V
Collector Current-Continuous 集電極電流-連續	I _c	300	mA
Collector Power Dissipation 集電極耗散功率	P _C	200	mW
Junction Temperature 結溫	T _j	150	°C
Storage Temperature Range 儲存溫度	T _{stg}	-55~150	°C

■DEVICE MARKING 打標

GMD780(2SD780)					
MARK	DW1	DW2	DW3	DW4	DW5
H _{FE1}	110~180	135~220	170~270	200~320	250~400



GMD780

■ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted 如無特殊說明,溫度為 25°C)

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Test Condition 測試條件	Min 最小值	Typ 典型值	Max 最大值	Unit 單位
Collector Cutoff Current 集電極截止電流	I_{CBO}	$V_{CB}=50\text{V},$ $I_E=0$	—	—	0.1	μA
Emitter Cutoff Current 發射極截止電流	I_{EBO}	$V_{EB}=5\text{V},$ $I_C=0$	—	—	0.1	μA
Collector-Base Breakdown Voltage 集電極-基極擊穿電壓	$V_{(BR)CBO}$	$I_C=100\mu\text{A}$	60	—	—	V
Collector-Emitter Breakdown Voltage 集電極-發射極擊穿電壓	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=1.0\text{mA}$	60	—	—	V
Emitter-Base Breakdown Voltage 發射極-基極擊穿電壓	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=100\mu\text{A}$	5	—	—	V
DC Current Gain 直流電流增益	H_{FE1}	$V_{CE}=1\text{V},$ $I_C=50\text{mA}$	110	200	400	—
DC Current Gain 直流電流增益	H_{FE2}	$V_{CE}=2\text{V},$ $I_C=300\text{mA}$	30	—	—	—
Collector-Emitter Saturation Voltage 集電極-發射極飽和壓降	$V_{CE(sat)}$	$I_C=300\text{mA},$ $I_B=30\text{mA}$	—	0.15	0.6	V
Base-Emitter Saturation Voltage 基極-發射極飽和壓降	$V_{BE(sat)}$	$I_C=300\text{mA},$ $I_B=30\text{mA}$	—	—	1.2	V
Base-Emitter Saturation 基極-發射極電壓	V_{BE}	$V_{CE}=6\text{V},$ $I_C=10\text{mA}$	0.6	0.64	0.7	V
Transition Frequency 特徵頻率	f_T	$V_{CE}=6\text{V},$ $I_C=10\text{mA}$	—	140	—	MHz
Collector Output Capacitance 輸出電容	C_{ob}	$V_{CB}=6\text{V}, I_E=0,$ $f=1\text{MHz}$	—	7	—	pF